

シリコンNPN拡散接合形トランジスタ
SILICON NPN DIFFUSED JUNCTION TRANSISTOR

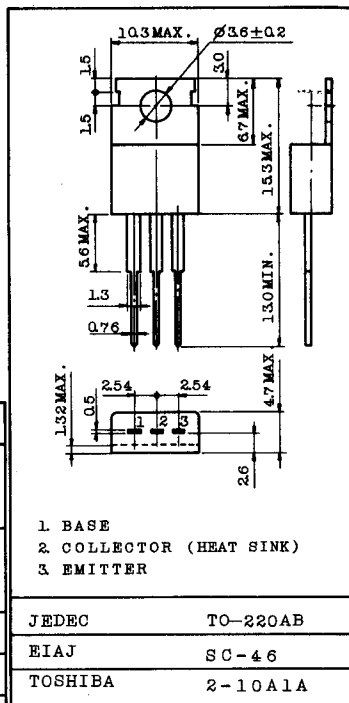
2SD234
2SD235

- 低周波電力増幅用
 - Audio Power Amplifier Applications
 - 飽和電圧が低い; $V_{CE(sat)} = 0.2V$ (Typ.)
($I_C = 1A$) 2SD235
 - 許容コレクタ損失が大きい; $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
 - 2SB434, 2SB435とコンプリメンタリになります。
 - Complementary to 2SB434 and 2SB435.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT	
コレクタ・ベース間電圧	2SD234	60	V	
	2SD235	50		
コレクタ・エミッタ間電圧	2SD234	50	V	
	2SD235	40		
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V	
コレクタ電流	I_C	3	A	
エミッタ電流	I_E	-3	A	
コレクタ損失	PC	$T_a = 25^\circ C$	1.5	W
		$T_c = 25^\circ C$	25	
接合温度	T_j	150	$^\circ C$	
存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$	

Unit in mm



アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No.AC75

2SD234 2SD235

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

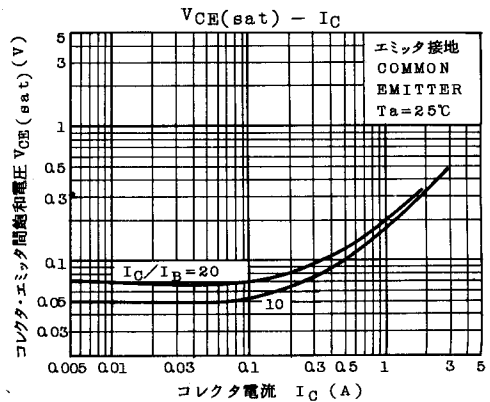
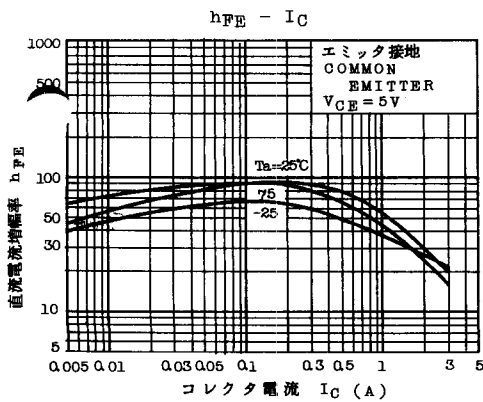
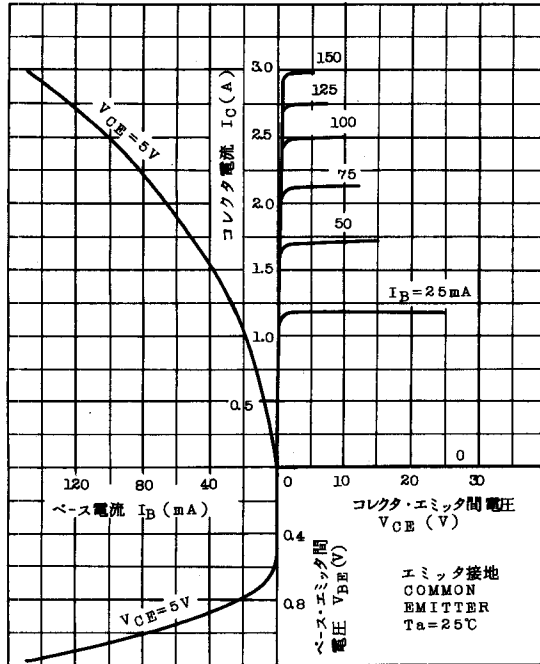
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20V, I_E=0$	—	—	100	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SD234 2SD235	$V_{(BR)CEC}$ $I_C=100mA$ $I_B=0$	50	—	—	V
			40	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	10	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	40	80	240	
直流電流増幅率	2SD234	$h_{FE(2)}$ $V_{CE}=5V, I_C=2.5A$	15	25	—	
	2SD235		$V_{CE}=5V, I_C=1A$	20	55	
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SD234	$V_{CE(sat)}$ $I_C=3A, I_B=0.3A$	—	0.5	1.2	V
	2SD235		$I_C=1A, I_B=0.05A$	—	0.2	
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	—	0.68	0.9	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_E=-0.5A$	—	1	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	250	—	pF

Note : $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

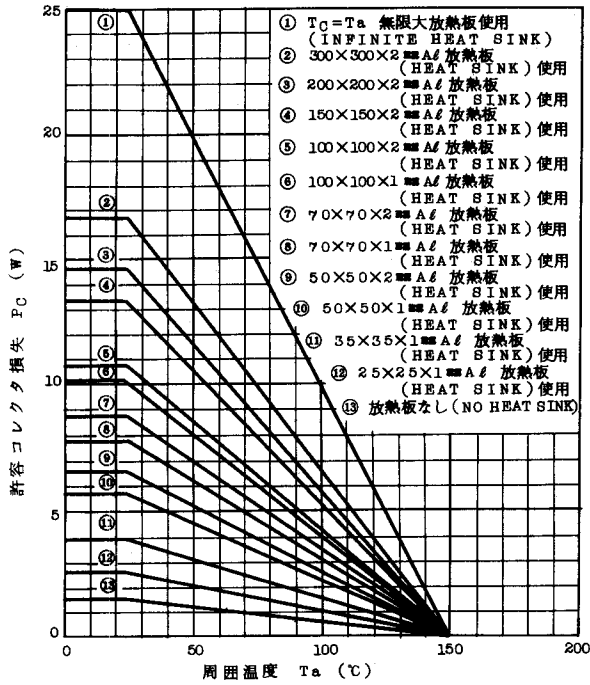
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SD234 and 2SD235 are classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SD234 - R 2SD235 - R	40	80
2SD234 - O 2SD235 - O	70	140
2SD234 - Y 2SD235 - Y	120	240

STATIC CHARACTERISTICS



PC - Ta



安全動作領域 ASO

